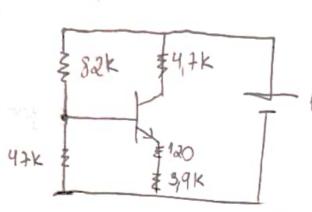
ALVES DE ALMEIDA CODRIGO ATIVIDADE 1 - ELES3 - GOMP 22

PRED:



$$I_{c} = 0.870 \text{ mA}$$

 $V_{E} = 4.02 \cdot 171 \cdot 5.12 \cdot 10^{3} = 3.524$
 $V_{B} = 3.58 + 0.7 = 4.28 \text{ V}$

•
$$\beta = 290$$

 $I_B = 3,67V = 3,06 \text{ MA}$
 $1199,7 \text{ KJL}$
 $I_C = 0,887 \text{ mA}$
 $V_E = 4,02 \cdot 291 \cdot 3,06 \cdot 10^{-3} = 3,58V$
 $V_C = 12 - 4,7 \cdot 10^3 \cdot 0,887 \cdot 10^{-3} = 7,83V$
 $V_D = 3.58 + 0.7 = 4.28V$

+ABEL1	A 2.1					,
	3	V _b (V)	VE (V)	V _C (V)	Iclm	1
teória	290	4,28	3,58	7,83	0,887	τ
	170	4,22	3,52	7,91	0,870	
Simulab	-		3,65	7,74		_

$$R_{c}//R_{L} = 3,19728 \text{ KL}$$

tabe	la 2.2 B	Vi(Vpp)	Vo (Vpp)	Av	/
teoria !	290	_	_	-21,38	T
1eoria	170]	-21,25	
Simulab	-	100 mVpp	2100 m Vpp	-21	,

Os resultados da Simulação mostram congordancia
com os valores obtidos teoricamente, e tom bem indicom
com os podo transistor no software e préximo dos
que o provincos utilizados neste exercíaio.